


	<h2 style="color: red;">FQP12N60C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP12N60C</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP12N60C.pdf 2.FQP12N60C.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 28111 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP12N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	28111 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 12A (Tc) 225W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	225W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2290pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP12N60C ist neu im Original, Suche FQP12N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP12N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP12N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP12N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A TO-220</p>	 <p>FQP12N20 FSC FQP12N20 FSC</p>	 <p>FQP12N50 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p>FQP12N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>
 <p>FQP12P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 11.5A TO-220</p>	 <p>FQP12P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 11.5A TO-220</p>	 <p>FQP12N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10.5A TO-220</p>	 <p>FQP12P10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 11.5A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP10N20	↔ FQP10N20	⇒ FQP10N20C	D FQP10N20C	⇒ FQP10N20L
⊕ FQP10N60B	⊗ FQP10N60C	D FQP10N60C	⇒ FQP10N60CF	⇒ FQP10N60C_07
⊗ FQP10N65	⊕ FQP10N65C	⊗ FQP10N80	↔ FQP11N40C	⇒ FQP11N40C
D FQP11N50CF	⊗ FQP11N50CF	⊕ FQP11N60	⊗ FQP11N60C	⇒ FQP11N65C
⇒ FQP11P06	↔ FQP11P06	⊗ FQP12N20	⊕ FQP12N60	⇒ FQP12N60
↔ FQP12N60C	⇒ FQP12N65C	D FQP12P10	⊗ FQP12P10	⊕ FQP12P20
⊗ FQP12P20	D FQP13N06	⇒ FQP13N06	↔ FQP13N06L	⇒ FQP13N06L
⊕ FQP13N10	⊗ FQP13N10	↔ FQP13N10L	⇒ FQP13N10L	⇒ FQP13N50
⊗ FQP13N50	⊕ FQP13N50C	⊗ FQP13N50C	D FQP13N60C	⇒ FQP140N03
↔ FQP140N03L	⊗ FQP14N15	⊕ FQP14N15	⊗ FQP14N30	⇒ FQP14N30

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited